

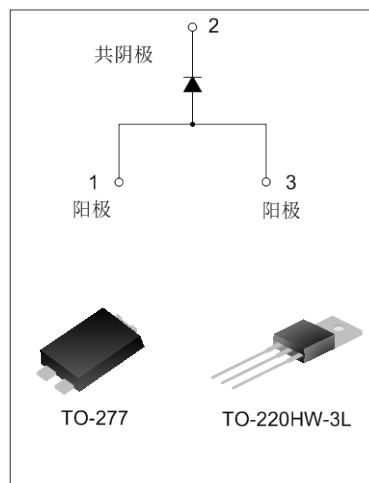
10A、45V肖特基整流管

描述

SBD10L45BT3/T 硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，广泛应用于开关电源、保护电路等各类电子线路中。

特点

- ◆ 具有过压保护的保护环结构
- ◆ 高电流冲击能力
- ◆ 低功耗，高效率
- ◆ 正向压降低



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SBD10L45BT3TR	TO-277	10L45B	无铅	编带
SBD10L45BT	TO-220HW-3L	SBD10L45BT	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	额定值	单位
最大反向峰值电压	V_{RRM}	45	V
正向平均整流电流	I_{FAV}	10	A
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	200	A
工作结温范围	T_J	125	$^\circ\text{C}$
芯片存储温度范围	T_{STG}	-55~125	$^\circ\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	额定值	单位
芯片对管壳热阻 (TO-277)	$R_{\theta jc}$	86.6	$^\circ\text{C/W}$

电参数规格(单管脚)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
正向压降	V_F	$I_F=5\text{A}$	$T_A=25^\circ\text{C}$	--	0.38	--	V
		$I_F=10\text{A}$		--	0.42	0.47	V
		$I_F=5\text{A}$	$T_A=125^\circ\text{C}$	--	0.28	--	V
		$I_F=10\text{A}$		--	0.35	0.41	V
反向漏电流	I_R	$V_R=45\text{V}$	$T_A=25^\circ\text{C}$	--	45	200	μA
		$V_R=45\text{V}$	$T_A=125^\circ\text{C}$	--	18	40	mA

典型特性曲线

图1、典型正向特性

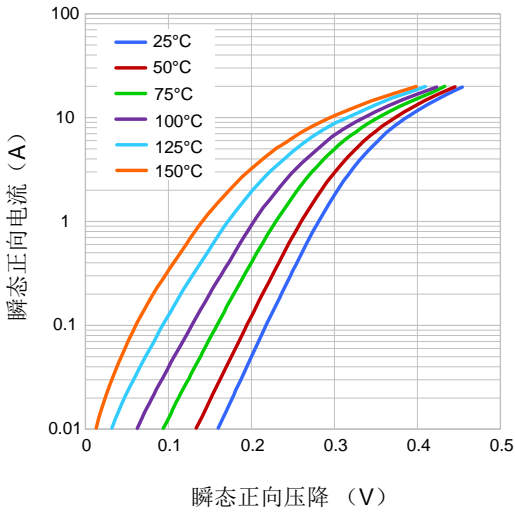


图2、典型反向特性

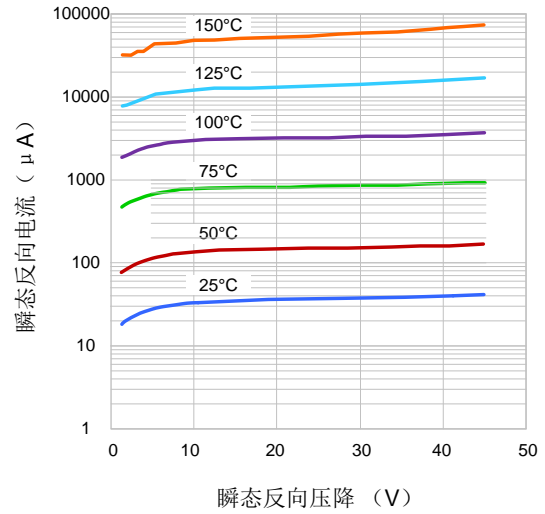


图3、电容和反向电压的关系

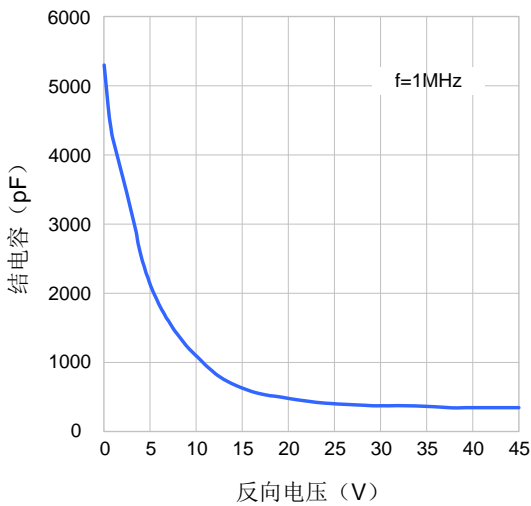
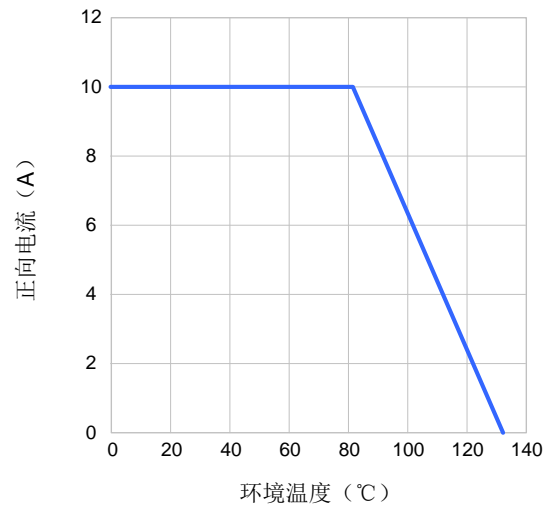
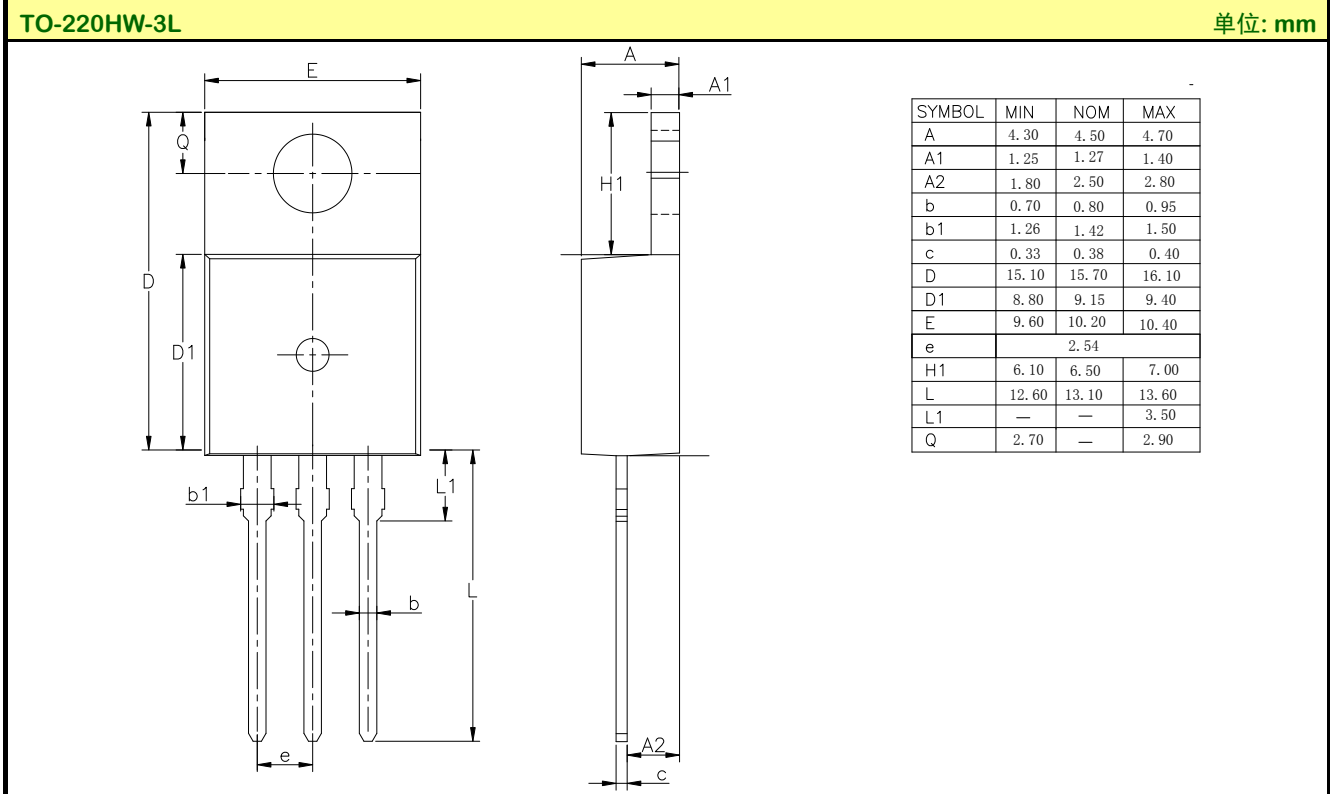
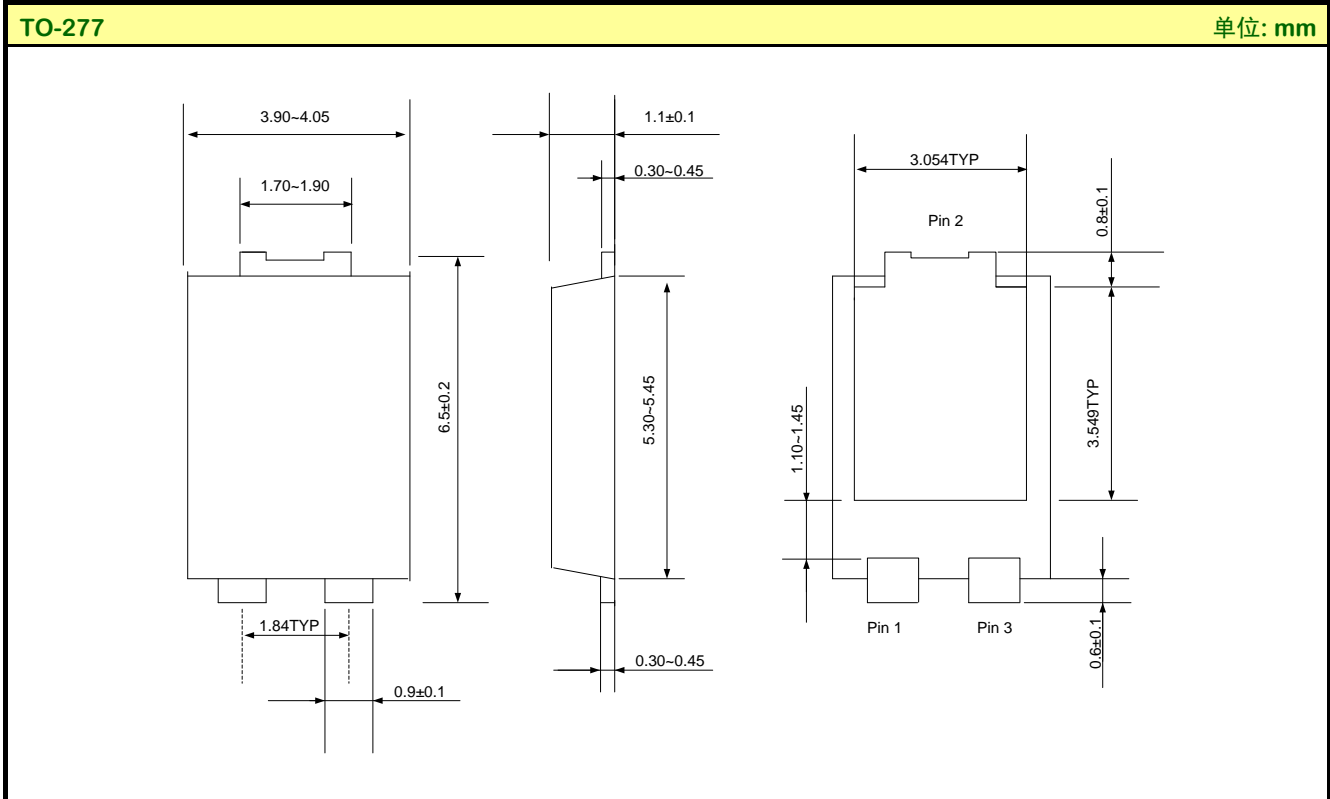


图4、正向电流降额曲线



封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SBD10L45BT3/T	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	1.0	作 者:	殷资
------	-----	------	----

修改记录:

1. 正式发布版本
-
-